

RoHS対応品

■特長

- 超小型低背セラミックパッケージ
2.0(L)×1.6(W)×0.55(H)mm(Typ.)
- シーム封止による高信頼性
- CMOS出力
- 電源電圧 1.8/ 2.5/ 3.3V兼用仕様
幅広い電源電圧範囲に対応 1.6~3.63V
- 低消費電流タイプ

■周波数許容偏差 (Overall)

許容偏差 コード × 10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備 考
O ± 50	-10 ~ +70	標準仕様
S ± 30		対応可能周波数についてはお問い合わせください
U ± 25		
F ±100		
G ± 50	-40 ~ +85	

■品名表示方法

KC2016B 40.0000 C 1 0 E 00
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名 (2.0×1.6mm SMD)
- ②出力周波数
- ③出力形態 (CMOS)
- ④電源電圧 (1.8V、2.5V、3.3V 兼用仕様)
- ⑤周波数許容偏差 (左記表を参照ください)
- ⑥シンメトリ/ INH機能 (45/ 55%、スタンバイ)
- ⑦客先個別仕様 (カタログ仕様は「00」になります)

包装形態 (テーピング 2000個/ リール)

■規格

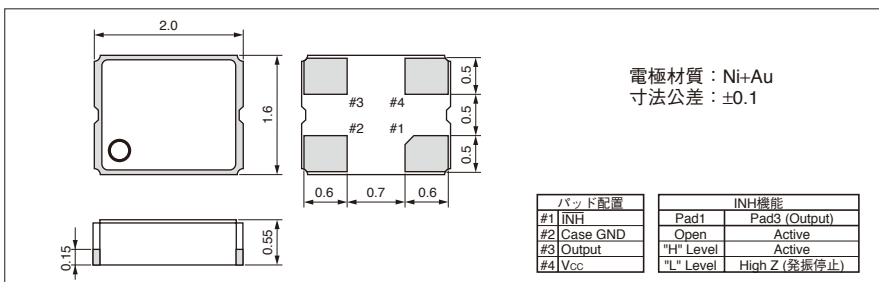
項 目	記 号	条 件	Min.	Max.	単 位	
出力周波数範囲*	fo		1.5	50	MHz	
周波数許容偏差**	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内の温度特性、電源電圧変動、負荷容量変動、経年変化 (1 year @25°C)、振動・衝撃を含む	Op. Temp. : -40 ~ +85°C	-100	+100	×10 ⁻⁶
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C / -40 ~ +85°C	-50	+50	
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C	-30	+30	
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C	-25	+25	
保存温度範囲	T _{stg}		-55	+125	°C	
動作温度範囲	T _{use}	標準仕様	-10	+70	°C	
		オプション	-40	+85		
最大定格電圧	—		-0.5	+6	V	
電源電圧	V _{CC}		1.6	3.63	V	
消費電流 (最大負荷時/ 1.6<V _{CC} <2.0V)	I _{CC}	1.5<fo<24MHz	—	2.5	mA	
		24<fo<40MHz	—	3.5		
		40<fo<50MHz	—	4.5		
消費電流 (最大負荷時/ 2.0<V _{CC} <2.8V)	I _{CC}	1.5<fo<24MHz	—	3		
		24<fo<40MHz	—	4.5		
		40<fo<50MHz	—	5		
消費電流 (最大負荷時/ 2.8<V _{CC} <3.63V)	I _{CC}	1.5<fo<24MHz	—	3.5		
		24<fo<40MHz	—	5		
		40<fo<50MHz	—	6		
スタンバイ時電流	I _{std}		—	10	μA	
波形シンメトリ	SYM	@50% V _{CC}	45	55	%	
立上り/ 立下り時間	tr/ tf		—	5	ns	
Lレベル出力電圧	V _{OL}	I _{OL} =4mA	—	10% V _{CC}	V	
Hレベル出力電圧	V _{OH}	I _{OH} =-4mA	90% V _{CC}	—	V	
出力負荷条件 (CMOS)	L_CMOS	CMOS Output	—	15	pF	
入力電圧範囲	V _{IN}		0	V _{CC}	V	
Lレベル入力電圧	V _{IL}		—	30% V _{CC}	V	
Hレベル入力電圧	V _{IH}		70% V _{CC}	—	V	
ディセーブル時間	t _{dis}		—	100	ns	
イネーブル時間	t _{ena}		—	5	ms	
発振開始時間	t _{str}	最小動作電圧を0 sec.とする	—	10	ms	
1Sigma Jitter	J _{Sigma}	Wavecrest DTS-2079 VIS/6.3.1にて測定	—	8	ps	
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}		—	80	ps	

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。

* レンジ外の周波数については、お問い合わせください。 ** -40~+85°C仕様に関しては、お問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

